

2SC3369

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形 / Si NPN Epitaxial Planar

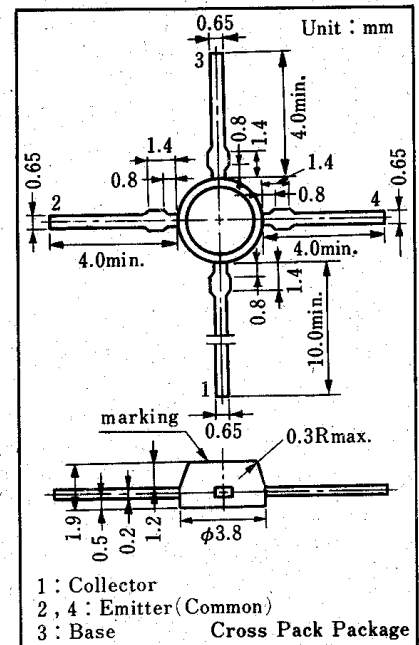
高周波電力増幅用 / RF Power Amplifier

■ 特徴 / Features

- 中出力である。 / Middle power output
- 高利得である。 / High gain

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings (Ta=25 °C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CEO}	16	V
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CES}	25	V
エミッタ・ベース電圧	V _{EBO}	3	V
せん頭コレクタ電流	I _{CP}	0.5	A
コレクタ電流	I _C	0.3	A
コレクタ損失 (Tc=25 °C)	P _C	1	W
接合部温度	T _j	135	°C
保存温度	T _{stg}	-55 ~ +135	°C



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics (Ta=25 °C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・シャ断電流	I _{CBO}	V _{CB} =20 V, I _E =0			100	μA
エミッタ・シャ断電流	I _{EBO}	V _{EB} =2V, I _C =0			500	μA
直流電流増幅率	h _{FE}	V _{CE} =10 V, I _C =100 mA*2	20			
コレクタ出力容量	C _{ob}	V _{CB} =10 V, I _E =0, f=1 MHz			6	pF
高周波出力	P _O *1	V _{CC} =8 V, P _{in} =45 mW, f=915 MHz	250	300		mW
熱抵抗	ΔV _{BE}	V _{CB} =10 V, I _E =-100 mA, t=0.8 s			80	mV

*1 エミッタ接地, *2 パルス測定 / Pulse Test

